

2SK2533

NチャンネルMOS形シリコン電解効果トランジスタ
超高速スイッチング

暫定規格

- 特長
- ・低オン抵抗。
 - ・高速ダイオ - ド内蔵。
 - ・面実装に対応し、工数低減およびセットの高密度化、小型化が可能となる。

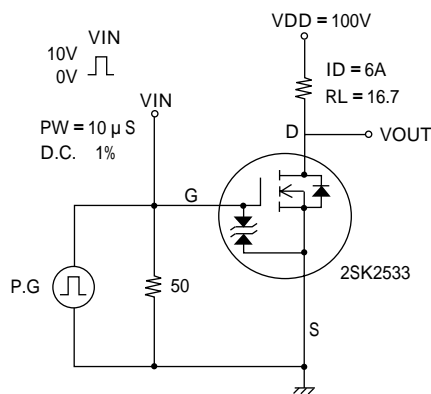
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25

項目	記号	値	単位
ドレイン・ソース電圧	VDSS	250	V
ゲート・ソース電圧	VGSS	± 30	V
ドレイン電流 (DC)	ID	13	A
ドレイン電流 (パルス)	IDP PW 10 μs, duty cycle 1%	52	A
許容損失	PD Tc=25	45	W
チャンネル温度	Tch	150	
保存周囲温度	Tstg	- 55 ~ + 150	

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25

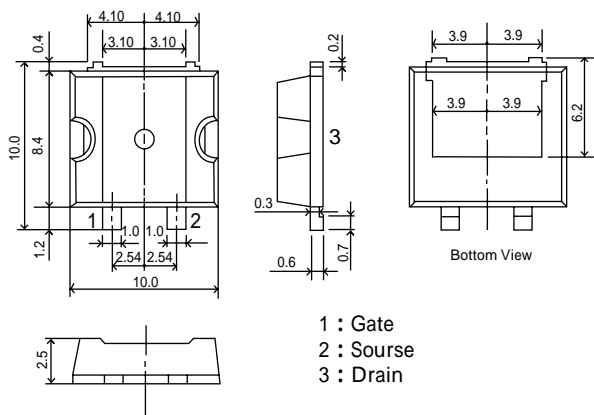
項目	記号	条件	min	typ	max	単位
ドレイン・ソース降伏電圧	V(BR)DSS	ID=1mA, VGS=0	250			V
ゲート・ソース降伏電圧	V(BR)GSS	IG= ± 100 μA, VGS=0	± 30			V
ドレイン・ソースシャ断電流	IDSS	VDS=250V, VGS=0			1.0	mA
ゲート・ソースもれ電流	IGSS	VGS= ± 25V, VDS=0			± 10	μA
ゲート・ソースシャ断電圧	VGS(off)	VDS=10V, ID=1mA	2.0		3.0	V
順伝達アドミタンス	yfs	VDS=10V, ID=6A	6.0	10		S
ドレイン・ソース間オン抵抗	RDS(on)	ID=6A, VGS=10V		200	270	m
入力容量	Ciss	VDS=20V, f=1MHz		1290		pF
出力容量	Coss	VDS=20V, f=1MHz		300		pF
帰還容量	Crss	VDS=20V, f=1MHz		125		pF
ターンオン遅延時間	td(on)	下図指定回路において		22		ns
立ち上がり時間	tr	"		66		ns
ターンオフ遅延時間	td(off)	"		320		ns
下降時間	tf	"		105		ns
ダイオード順電圧	VSD	IS = 12A, VGS = 0		1.0	1.5	V
ダイオード逆回復時間	trr	IS = 12A, di/dt=100A/μs		160		ns

スイッチングタイム測定回路図



外形図

ZP(unit:mm)



これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。



LittleDiode supplies new, hard to find or obsolete electronic components and semiconductors all over the world.

With over two million different components listed you are sure to find the part you need.

Feel free to visit us today at our online store:

LittleDiode.com

Looking forward to providing you with the best possible service.